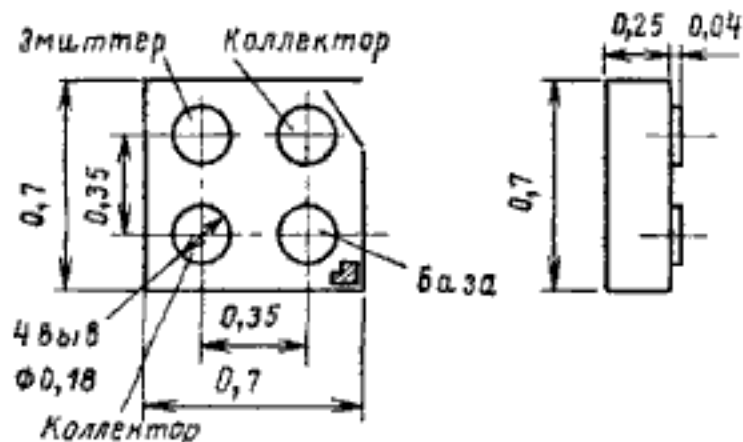


КТ210А, КТ210Б, КТ210В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* низкочастотные усилительные маломощные

Бескорпусные с твердыми выводами Обозначение типа приводится на таре

Масса транзистора не более 0,005 г



Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 1$ мА не менее	10 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 1$ мА	
КТ210А, КТ210Б	80—240
КТ210В	40—120
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	0,5 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более	1 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ \text{ макс.}}$, $R_{ЭБ} = 10$ кОм не более	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 10$ В не более	5 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 3$ МГц не более	25 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 5$ МГц не более	10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
КТ210А	15 В
КТ210Б	30 В
КТ210В	60 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq$ ≤ 10 кОм:	
KT210A	15 В
KT210Б	30 В
KT210В	60 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	10 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Импульсный ток коллектора	40 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 308$ К	25 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 308$ К	40 мВт
Тепловое сопротивление переход-среда	3 К/мВт
Температура перехода	398 К
Температура окружающей среды	От 213 до 358 К